P21030.P03

#### IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: Y. HARADA et al.

Appl No.: Not Yet Assigned

**PCT Branch** 

I.A. Filed: December 4, 2000

PCT/JP00/08584

For

:INTERNAL MEMBER FOR PLASMA-TREATING VESSEL AND METHOD OF

PRODUCING THE SAME

**CLAIM OF PRIORITY** 

Commissioner of Patents and Trademarks

Washington, D.C. 20231

Sir:

Applicant hereby claims the right of priority granted pursuant to 35 U.S.C. 119 based upon Japanese Application No. 11-351546, filed December 10, 1999. The International Bureau already should have sent a certified copy of the Japanese application to the United States designated office. If the certified copy has not arrived, please contact the undersigned.

> Respectfully submitted, Y. HARADA et al.

Reg. No. 29,027

August 3, 2001 GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C. 1941 Roland Clarke Place Reston, VA 20191 (703) 716-1191

THIS PAGE BLANK (USPTO)

特許協力条約に基づく国際出願願書 原本(出願用) - 印刷日時 2000年12月01日 (01.12.2000) 金曜日 13時34分06秒

回療出願音   日本国   日日   日本国   日本日	1-5en   Address:   11-5en   Address:   11-1-5en   11-1-5en   Address:   11-1-5en	0	双油亭宁河 梅	<b>Y</b>
国際出願日	1-5en   Address:	-		
日本国	日本国	0-1	国際出願番号.	
日本国	日本国			
日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	日本国際	0-2	国際出頭口	
でである	日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本			1 0 4 12 0 0 1
PCT-EASY Version 2.91 (updated 10.10.2000)   PCT-EASY Version	検式-PCT/BO/101			1 3
PCT-EASY Version 2.91 (updated 10.10.2000)   PCT-EASY Version	検式-PCT/BO/101			→ 3 NE 2→ 7
PCT-EASY Version 2.91 (updated 10.10.2000)   PCT-EASY Version	検式-PCT/BO/101	0-3	(受付印)	(ダマア)
Comparison (1997)   Co	この特許協力条約に基づく国際			
Comparison (1997)   Co	CO 特許協力条約に基づく国際			
Comparison (1997)   Co	CO 特許協力条約に基づく国際			<u> </u>
Comparison (1997)   Co	CO 特許協力条約に基づく国際	0-4	接	T
日本国際書は、	出願願書は、右記によって作成された。	• •		
日記によって作成された。	日記によって作成された。		この特許協力条約に基つく国際	i
11-5en   日本国   日本国特許庁 (RO/JP)   日本国人文は代理人の書類記号   日本国特許庁 (RO/JP)   日本国人文は代理人の書類記号   日本国人文は代理人の書類記号   日本国人である(applicant only)   米国を除くすべての指定国(all designated State except US)   トーカロ株式会社   TOCALO CO., LTD.   658-0013 日本国   日本国	日本国外によって地域が特許協力条約に従って処理されることを請求する。   日本国特許庁 (RO/JP)   日本国特許庁 (RO/JP)   日本国人によって指定された受理   日本国特許庁 (RO/JP)   日本国人によって指定された受理   日本国特許庁 (RO/JP)   日本国人によって指定された受理   日本国人によって指定された受理   日本国人によって指定国についての関係と   日本の指定国についての出願人である(applicant only)   米国を除くすべての指定国(all designated Stexcept US)   トーカロ株式会社   TOCALO CO., LTD.   658-0013 日本国   兵庫県 神戸市   東灘区深江北町4丁目13番4号   13-4, Fukae-kitamachi 4-chome, Higashinada-Kobe-shi, Hyogo 658-0013   Japan   日本国 JP   日本日 JP   日本日 JP   日本日 JP   日本日 (All designated Stexcept US)   東京 JT   JT   JT   JT   JT   JT   JT   JT			
11-5en   日本国   日本国特許庁 (RO/JP)   日本国人文は代理人の書類記号   日本国特許庁 (RO/JP)   日本国人文は代理人の書類記号   日本国人文は代理人の書類記号   日本国人である(applicant only)   米国を除くすべての指定国(all designated State except US)   トーカロ株式会社   TOCALO CO., LTD.   658-0013 日本国   日本国	日本国	0-4-1	右記によって作成された。	PCT-FASY Version 2 91
中立て	中立て		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
出願人は、この国際出願が特許協力条約に従って処理されることを請求する。   出願人によって指定された受理官庁	出願人は、この国際出願が特許 協力条約に従って処理されることを請求する。 0-6 出願人によって指定された受理 官庁 0-7 出願人又は代理人の書類記号 けいての出願人である。 (applicant only) ボ国を除くすべての指定国(all designated Stexcept US) トーカロ株式会社 TOCALO CO., LTD. 658-0013 日本国 兵庫県 神戸市 東灘区深江北町4丁目13番4号 13-4, Fukae-kitamachi 4-chome, Higashinada- Kobe-shi, Hyogo 658-0013 Japan 11-8 電話番号 ファクシミリ番号 での他の出願人では発明者 111-1-12 この相に記載した者は 右の指定国についての出願人である(applicant only) 米国を除くすべての指定国(all designated Stexcept US) トーカロ株式会社 TOCALO CO., LTD. 658-0013 日本国 兵庫県 神戸市 東灘区深江北町4丁目13番4号 13-4, Fukae-kitamachi 4-chome, Higashinada- Kobe-shi, Hyogo 658-0013 Japan 日本国 JP 日本国 JP 078-411-5561 078-452-8178 出願人である(applicant only) 米国を除くすべての指定国(all designated Stexcept US) 東京エレクトロン株式会社 TOKYO ELECTRON CO., LTD. 107-0052 日本国 東京都 港区 赤坂5丁目3番6号 3-6, Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan			(updated 10.10.2000)
とを請求する。	Lを請求する。	0-5		
とを請求する。	Lを請求する。		出願人は この国際出願が特許	
とを請求する。	とを請求する。		切力冬約に従って加理される。	
田願人によって指定された受理	田願人によって指定された受理		助力未利に促って処理されるこ	
日本国人によりで指定された文庫	日本国代記録   日本国   日本国代記録   日本国   日本日   日本		とを前氷する。	
信庁	信庁	0-6	出願人によって指定された受理	日本国特許庁(RO/JP)
出願人又は代理人の書類記号	出願人又は代理人の書類記号   日田   日田   日田   日田   日田   日田   日田   日		官庁	
発明の名称	一	0-7		CU1222_DCT
HII	出願人	-		
出願人   二-1	出願人	_	発明の名称	プラズマ処理容器内部材およびその製造方法
II-1	II-1   この欄に記載した者は   右の指定国についての出願人である	II	<b>出顧人</b>	
II-2   右の指定国についての出願人である。	11-2   右の指定国についての出願人である。	I I - 1		UIDE 1 7 (11)
II-4ja   名称   Name   TOCALO CO., LTD.   G58-0013 日本国   兵庫県 神戸市東灘区深江北町4丁目13番4号   13-4, Fukae-kitamachi 4-chome, Higashinada-ku, Kobe-shi, Hyogo 658-0013	II-4ja   II-4en   II-5ja   Address:   Ad			
II-4ja   II-4en   Name   Name   TOCALO CO., LTD.   Hocal Co.,	II-4ja   II-4en   Name   Name   TOCALO CO., LTD.   658-0013 日本国   兵庫県 神戸市東灘区深江北町4丁目13番4号   13-4, Fukae-kitamachi 4-chome, Higashinada-Kobe-shi, Hyogo 658-0013 Japan   日本国 JP   日本国	11-2	右の指定国についての出願人で	米国を除くすべての指定国(all designated States
II-4ja       名称       トーカロ株式会社         II-4en       Name       TOCALO CO., LTD.         II-5ja       あて名:       658-0013 日本国兵庫県神戸市東灘区深江北町4丁目13番4号         II-5en       Address:       13-4, Fukae-kitamachi 4-chome, Higashinada-ku, Kobe-shi, Hyogo 658-0013 Japan         II-6       国籍(国名)       日本国 JP         II-7       住所(国名)       日本国 JP         II-8       電話番号       078-411-5561         II-9       ファクシミリ番号       078-452-8178         III-1-1       この欄に記載した者は右の指定国についての出願人である(applicant only)米国を除くすべての指定国(all designated State except US)東京エレクトロン株式会社 TOKYO ELECTRON CO., LTD.	II-4ja		ある。	
II-4en	II-4en   II-5ja   Bar	YT 44.		except us)
II-4en   II-5ja   Name   あて名:   TOCALO CO., LTD.   658-0013 日本国   兵庫県 神戸市   東灘区深江北町4丁目13番4号   13-4, Fukae-kitamachi 4-chome, Higashinada-ku, Kobe-shi, Hyogo 658-0013   Japan   日本国 JP   日本国	II-4en   II-5ja   Name   あて名:	11-4Ja	名称	トーカロ株式会社
II-5ja   あて名:   658-0013 日本国   兵庫県 神戸市   東灘区深江北町4丁目13番4号   13-4, Fukae-kitamachi 4-chome, Higashinada-ku, Kobe-shi, Hyogo 658-0013   Japan   日本国 JP   日本	II-5ja   あて名:   658-0013 日本国   兵庫県 神戸市   東灘区深江北町4丁目13番4号   13-4, Fukae-kitamachi 4-chome, Higashinada-Kobe-shi, Hyogo 658-0013   Japan   日本国 JP   日本国 JP	II-4en	Name	
III-5en   Address:   Cose-Wolfs 日本国   兵庫県 神戸市   東灘区深江北町4丁目13番4号   13-4, Fukae-kitamachi 4-chome, Higashinada-ku, Kobe-shi, Hyogo 658-0013   Japan   日本国 JP   日本国	III-5en   Address:   Gos Out of Date	f1 52-		
III-5en兵庫県 神戸市 東灘区深江北町4丁目13番4号III-5enAddress:13-4, Fukae-kitamachi 4-chome, Higashinada-ku, Kobe-shi, Hyogo 658-0013 JapanIII-6国籍(国名) 住所(国名)日本国 JP 日本国 JP 	兵庫県 神戸市 東灘区深江北町4丁目13番4号   13-4, Fukae-kitamachi 4-chome, Higashinada-Kobe-shi, Hyogo 658-0013   Japan   日本国 JP   日本国 (All designated Stexcept US)   日本国 (All designated Stexcept US)   東京エレクトロン株式会社   TOKYO ELECTRON CO., LTD.   日本国 東京都 港区   市本国 東京都 港区   市本国 東京都 港区   市本国 東京都 (All designated Stexcept US)   日本国 東京都 港区   日本国 東京都 (All designated Stexcept US)   日本国 東京都 港区   日本国 東京都 (All designated Stexcept US)   日本国 東京都 港区   日本国 東京都 (All designated Stexcept US)   日本国 東京都 港区   日本国 東京都 (All designated Stexcept US)   日本国 東京都 港区   日本国 東京都 (All designated Stexcept US)   日本国 東京都 港区   日本国 東京都 (All designated Stexcept US)   日本国 東京都 (All designated Stexcept US)   日本国 東京都 港区   市本国 東京都 (All designated Stexcept US)   日本国 東京都 港区   日本	11-5]a	あて名:	658-0013 日本国
東灘区深江北町4丁目13番4号   13-4, Fukae-kitamachi 4-chome, Higashinada-ku, Kobe-shi, Hyogo 658-0013   Japan   日本国 JP   日本国 JP	R			丘庫県   神石市
II-5en	II-5en   Address:   13-4, Fukae-kitamachi 4-chome, Higashinada-Kobe-shi, Hyogo 658-0013   Japan   日本国 JP   日本 JP	:		
III-6	III-6   国籍 (国名)			果灘区深江北町4」日13番4号
III-6	III-6	II-5en	Address:	13-4 Fukae-kitamachi 4-chome Higashinada-ku.
II-6	II-6			When the Human 650 0012
II-6	II-6			
II-6	II-6			Japan
II-7       住所(国名)       日本国 JP         II-8       電話番号       078-411-5561         II-9       ファクシミリ番号       078-452-8178         III-1       その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は 右の指定国についての出願人である(applicant only) 米国を除くすべての指定国(all designated State except US) 東京エレクトロン株式会社 TOKYO ELECTRON CO., LTD.	II-7   住所 (国名)   信話番号   078-411-5561   078-452-8178   III-9   ファクシミリ番号   O78-452-8178   III-1-1   その他の出願人又は発明者   この欄に記載した者は   出願人である (applicant only)   米国を除くすべての指定国 (all designated Stexcept US)   東京エレクトロン株式会社   TOKYO ELECTRON CO., LTD.   107-0052 日本国東京都 港区   赤坂5丁目3番6号   3-6, Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052   Japan	11-6	国籍 (国名)	
II-8	III-8			
Til-8	Til-8	11-1	任所(国名)	日本国 JP
III-9	III-9	II-8	雷話番号	
III-1	III-1-1	0-11		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
III-1-1 この欄に記載した者は 右の指定国についての出願人である(applicant only) 米国を除くすべての指定国(all designated State except US) 東京エレクトロン株式会社 TOKYO ELECTRON CO., LTD.	III-1-1 この欄に記載した者は 右の指定国についての出願人である(applicant only) 米国を除くすべての指定国(all designated Stexcept US) 東京エレクトロン株式会社 TOKYO ELECTRON CO., LTD. 107-0052 日本国 東京都 港区 赤坂5丁目3番6号 3-6, Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan			0/8-452-81/8
III-1-1 この欄に記載した者は 右の指定国についての出願人である(applicant only) 米国を除くすべての指定国(all designated State except US) 東京エレクトロン株式会社 TOKYO ELECTRON CO., LTD.	III-1-1 この欄に記載した者は 右の指定国についての出願人である(applicant only) 米国を除くすべての指定国(all designated Stexcept US) 東京エレクトロン株式会社 TOKYO ELECTRON CO., LTD. 107-0052 日本国 東京都 港区 赤坂5丁目3番6号 3-6, Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan	III-I	その他の出願人又は発明者	,
TIII-1-2 右の指定国についての出願人である。  TIII-1-4ja A称  III-1-4en Name  Aの指定国についての出願人で表現を除くすべての指定国 (all designated State except US) 東京エレクトロン株式会社 TOKYO ELECTRON CO., LTD.	#国を除くすべての指定国(all designated Stexcept US) #RIII-1-4ja A称 #Will-1-4en Name #RIII-1-5ja おて名: #RIII-1-5ja おで名: #RIII-1-5ja おでは、 Address: #RIII-1-5en Address:	III-1-1	この欄に記載した老け	出願しておる (applicant only)
ある。 except US) A称 東京エレクトロン株式会社 TOKYO ELECTRON CO., LTD.	Address:   except US   東京エレクトロン株式会社   TOKYO ELECTRON CO., LTD.   107-0052 日本国東京都 港区   赤坂5丁目3番6号   3-6, Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052   Japan			山根へ Cのる (apprically Olly)
Bas   except US     A称   東京エレクトロン株式会社   TOKYO ELECTRON CO., LTD.	Except US	111-1-2	石の指定国についての出願人で	米国を除くすべての指定国(all designated States
III-1-4ja 名称 東京エレクトロン株式会社 TOKYO ELECTRON CO., LTD.	III-1-4ja       名称       東京エレクトロン株式会社         III-1-5ja       TOKYO ELECTRON CO., LTD.         III-1-5ja       107-0052 日本国東京都 港区         赤坂5丁目3番6号       3-6, Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan		ある。	except IIS)
TOKYO ELECTRON CO., LTD.	Name TOKYO ELECTRON CO., LTD. 107-0052 日本国東京都 港区 赤坂5丁目3番6号 3-6, Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan	[]]-1-4 in	t la	
TOKYO ELECTRON CO., LTD.	Name			果只エレクトロン株式会社
	III-1-5ja あて名: 107-0052 日本国東京都 港区東京都 港区 赤坂5丁目3番6号 3-6, Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan	III-1-4en	Name	TOKYO FLECTRON CO LTD
***・**** の(右:   110/-005/ 日本国	東京都 港区 赤坂5丁目3番6号 3-6, Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan			1407 00E0 CI
	赤坂5丁目3番6号 Address: 3-6, Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan	111 1 0 16	の(名:	
東京都 港区	赤坂5丁目3番6号 Address: 3-6, Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan			東京都 港区
	Address:  3-6, Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan			
	Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan		4.13	
	Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan	111-1-5en	Address:	13-6. Akasaka 5-chome.
	Japan			
III-1-5en Address: 3-6, Akasaka 5-chome,		1		
Address: 3-6, Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052				Japan
Address:  3-6, Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan	''' ' ' '   国籍 ( 国名 )	III-1-6	国籍(国名)	
Address:  3-6, Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan		111-1-7		
Address:  3-6, Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan 日本国 JP	…··   注加(閏名)   <b>  日本国 JP</b>		11/17(国名)	日本国 パ
東京都港区		III-1-5ja	あて名:	107-0052 日本国  東京都 港区  赤坂5丁目3番6号   3-6, Akasaka 5-chome,   Minato-ku, Tokyo 107-0052
	Address:  3-6, Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan			亦収3」日3番0号
	Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan	111-1-5en	Address:	13-6. Akasaka 5-chome.
	Japan			
III-1-5en Address: 3-6, Akasaka 5-chome,	Japan			Minato-ku, lokyo 10/-0052
Address: 3-6, Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052				l Japan
Address: 3-6, Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052		III-1-6	国籍 (国名)	
Address:  3-6, Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan		711-1 77		
Address:  3-6, Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan 日本国 JP		111 1-1	1生// (国名)	日本国 パ
Address:  3-6, Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan				

THIS PAGE BLANK (USETO)

特許協力条約に基づく国際出願願書 原本(出願用) - 印刷日時 2000年12月01日 (01.12.2000) 金曜日 13時34分06秒

111-2	その他の出願人又は発明者	T
III-2-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
III-2-2	右の指定国についての出願人で	米国のみ (US only)
	ある。	
	氏名(姓名)	原田  良夫
III-2-4en	Name (LAST, First)	HARADA, Yoshio
III-2-5ja	あて名:	674-0057 日本国
III-2-5en	Address:	兵庫県 明石市 大久保町高丘1丁目8番18号 8-18, Takaoka 1-chome, 0kubo-cho Akashi-shi, Hyogo 674-0057 Japan
111-2-6	国籍 (国名)	日本国 JP
III-2-7	住所 (国名)	日本国 JP
111-3	その他の出願人又は発明者	
III-3-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である(applicant and inventor)
III-3-2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
III-3-4ja	氏名(姓名) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	竹内 純一
	Name (LAST, First)	TAKENCHI boichi
	あて名:	TAKEUCHI, Junichi 658-0012 日本国
III-3-5en	Address:	兵庫県 神戸市 東灘区本庄町2丁目5番12号706 706,5-12, Honjo-cho 2-chome, Higashinada-ku Kobe-shi, Hyogo 658-0012 Japan
111-3-6	国籍 (国名)	日本国 JP
	住所 (国名)	日本国 JP
	その他の出願人又は発明者	
III-4-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である(applicant and inventor)
III-4-2	右の指定国についての出願人で	米国のみ (US only)
TTT 4 4 *	ある。	
	氏名(姓名)	濱口 竜哉
111-4-4en	Name (LAST, First)	HAMAGUCHI, Tatsuya
III-4-5ja	あて名:	226-0002 日本国
III-4-5en	Address:	神奈川県 横浜市 緑区東本郷4丁目13番12号 ビーライン6 102号室 102, Villa Inn 6, 13-12, Higashihongo 4-chome, Midori-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 226-0002
III-4-6	国籍(国名)	Japan 日本国 JP
	住所(国名)	日本国 JP
		다 쑤므 V「

THIS PAGE BLANK (USPTO)

特許協力条約に基づく国際出願願書 原本(出願用) - 印刷日時 2000年12月01日 (01.12.2000) 金曜日 13時34分06秒

TII-5	Let a /III. a LLIER Let 1 Manage	
III-5 III-5-1	その他の出願人又は発明者	United 1 To an Phonocity and the Transfer of 1
III-5-1	この欄に記載した者は  右の指定国についての出願人で	出願人及び発明者である (applicant and inventor)  米国のみ (US only)
111-5-41	ある。	(co ciy)
	五 氏名(姓名)	長山、将之
111-3-40	Name (LAST, First)	NAGAYAMA, Nobuyuki
111-5-5]8	あて名:	407-0003 日本国
III-5-5er	Address:	山梨県 韮崎市 藤井町北下条2381番地の1 東京エレクトロン山梨株式会社内 c/o TOKYO ELECTRON YAMANASHI CO., LTD. 2381-1, Kitagejo, Fujiicho Nirasaki-shi, Yamanashi 407-0003
		Japan
111-5-6	国籍(国名)	日本国 JP
111-5-7	住所 (国名)	日本国 JP
III-6	その他の出願人又は発明者	
III-6-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である(applicant and inventor)
III-6-2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ(US only)
III-6-4ja	氏名(姓名)	三橋 康至
	Name (LAST, First)	
III-6-5 ia	あて名:	MITSUHASHI, Kouji
111 0 0,12	あて石:	407-0003 日本国 山梨県 韮崎市
III-6-5en	Address:	藤井町北下条2381番地の1 東京エレクトロン山梨株式会社内 c/o TOKYO ELECTRON YAMANASHI CO,. LTD. 2381-1, Kitagejo, Fujiicho, Nirasaki-shi, Yamanashi 407-0003
III <b>-6-6</b>	国籍(国名)	Japan 日本国 JP
III-6-7	住所 (国名)	日本国 JP
<b>IV</b> -1	代理人又は共通の代表者、通知	
į	のあて名 下記の者は国際機関において右 記のごとく出願人のために行動 する。	代理人(agent)
	氏名(姓名)	小川 順三
IV-1-1en	Name (LAST, First)	OGAWA, Junzo
	あて名:	104-0061 日本国
		東京都 中央区 銀座2丁目8番9号 木挽館銀座ビル
		Kobikikan Ginza Bldg.
		8-9, Ginza 2-chome Chuo-ku, Tokyo 104-0061 Japan
IV-1-3		03-3561-2211
IV-1-4		03-3561-1546
IV-1-5	<b>電子メール</b>	ogawapat@jade.dti.ne.jp
IV-2	その他の代理人	筆頭代理人と同じあて名を有する代理人 (additiona)
ļ		agent(s) with same address as first named agent)
IV-2-ija		中村 盛夫
		NAKAMURA, Morio
		MINIOUS TO TO

THIS PAGE BLANK (USPTO)

特許協力条約に基づく国際出願願書 原本(出願用) - 印刷日時 2000年12月01日 (01.12.2000) 金曜日 13時34分06秒

V	国の指定		
V-1	広域特許	FP AT BE CHALL CY DE D	K ES FI FR GB GR IE IT LU
	(他の種類の保護又は取扱いを	MC NL PT SE TR	. Lo . L . A GO GIV IL II LO
	求める場合には括弧内に記載す		と特許協力条約の締約国で
	(る。)	ある他の国	こうもにはないとでもつららればられば
V-2	国内特許	KR US	
	(他の種類の保護又は取扱いを	IN OO	
	求める場合には括弧内に記載す		
V-5	る。)		
V-0	指定の確認の宣言	<u>'</u>	
	出願人は、上記の指定に加えて 、規則4.9(b)の規定に基づき、	1	
	特許協力条約のもとで認められ		
	特許協力条約のもとで認められる他の全ての国の指定を行う。		
	ただし、V-6欄に示した国の指		
	定を除く。出願人は、これらの	·	
	は加される指定が確認を条件としていること、並びに優先日か		•
	「ら15月が経過する前にその確認	Company of the State of the Sta	•
	がなされない指定は、この期間 の経過時に、出願人によって取		
	の経過時に、出願人によって取		
	り下げられたものとみなされることを宣言する。		. •
V-6	指定の確認から除かれる国	なし (NONE)	
VI-1	先の国内出願に基づく優先権主	A C (NONE)	
	張		
VI-1-1	先の出願日	1999年12月10日(10.12.1	999)
VI-1-2	先の出願番号	特願平11-351546	
VI-1-3	国名	日本国 JP	
VI-2	優先権証明書送付の請求		
	上記の先の出願のうち、右記の	VI-1	
	番号のものについては、出願書類の認証謄本を作成し国際事務		
	局へ送付することを、受理官庁		
	局へ送付することを、受理官庁 に対して請求している。		
VII-I	特定された国際調査機関(ISA)	日本国特許庁(ISA/JP)	
VIII	照合欄	用紙の枚数	添付された電子データ
VIII-1	願書	5	<u> </u>
VIII-2	明細書	12	-
VIII-3	請求の範囲	2	_
VIII-4	要約	1	abstract(gh1233-pct).txt
VIII-5	図面	0	-
VIII-7	合計	20	
	添付書類	添付	添付された電子データ
8-IIIV	手数料計算用紙	<b>✓</b>	-
. VIII-9	別個の記名押印された委任状	✓	_
VIII-16	PCT-EASYディスク	_	フレキシブルディスク
VIII-17	その他	納付する手数料に相当す	-
		る特許印紙を貼付した書	
		回	
VIII-17	その他	国際事務局の口座への振	1-
	C 97 IE	り込みを証明する書面	
VIII-18	要約費とともに提示する図の番	ンとので見らりの可用	1
	号		
VIII-19	国際出願の使用言語名:	日本語(Japanese)	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

THIS PAGE BLANK (USPTO)

特許協	力条約に基づく国際出願願書   原本 (出顧用) - 印刷日	時 2000年12月01日 (01.12.2000) 金曜日 13時34分06秒	GH1233-PCT
IX-1	提出者の記名押印		
IX-1-1	氏名(姓名)	小川 順三	_
TX-2	提出者の記名押印		
IX-2-1	氏名(姓名)	中村 盛夫	<del></del>
	•	受理官庁記入欄	
10-1	国際出願として提出された書類 の実際の受理の日		
10-2	図面:		
10-2-1 10-2-2	受理された 不足図面がある	·	
10-3	国際出願として提出された書類 を補完する書類又は図面であっ てその後期間内に提出されたも のの実際の受理の日(訂正日)		
10-4	特計協力条約第11条(2)に基つ   く必要な補完の期間内の受理の   日		
10-5	出願人により特定された国際調 査機関	ISA/JP	
10-6	調査手数料未払いにつき、国際 調査機関に調査用写しを送付し ていない		
		<b>眾際事務局記入欄</b>	

THIS PAGE BLANK (USPYO)

# 明細書

プラズマ処理容器内部材およびその製造方法

#### 5 技術分野

本発明は、耐プラズマエロージョン性に優れるプラズマ処理容器内部材とその製造方法に関するものである。

とくに本発明は、ハロゲン元素を含む処理ガスを用いるプラズマ雰囲気での プラズマ処理に際して使用される部材、例えば、デポシールド、バッフルプレ 10 ート、フォーカスリング、インシュレータリング、シールドリング、ベローズ カバー、電極などの部材に適用できる技術である。

なお、本発明は、半導体製造装置の他、液晶デバイス製造装置の分野などに おけるプラズマ処理容器内部品に対して適用が可能である。

#### 15 背景技術

一般に、半導体や液晶デバイスなどの製造プロセスでは、各種の処理において、 $BF_3$ や  $NF_3$ のようなふっ化物、 $BCl_3$ や  $SnCl_4$ などの塩化物、HBr の如き臭化物などが処理ガスとして使用されるため、処理容器内の部材が著しく腐食損耗するという問題点があった。

20 例えば、半導体製造装置のプラズマ処理容器内に使われる材料としては、Al や Al 合金などの金属材料、金属材料表面に被覆される Al の陽極酸化膜、ボロンカーバイドなどの溶射皮膜、 $Al_2O_3$  や  $Si_3N_4$  などの焼結体皮膜、あるいはふっ素樹脂やエポキシ樹脂などの高分子皮膜が知られている。これらの材料は、腐食性の強いハロゲンイオンに接すると、化学的損傷を受けたり、 $SiO_2$ 、 $Si_3N_4$  などの微粒子、およびプラズマによって励起されたイオンによって、エロージョン損傷を受けることが知られている。

とくに、ハロゲン化合物を用いるプロセスでは、反応のより一層の活性化を

WO 01/42526 PCT/JP00/08584

図るため、しばしばプラズマが用いられる。しかし、このようなプラズマ使用環境下では、ハロゲン化合物は解離して非常に腐食性の強い原子状のF、Cl、Br、I などを発生する。この場合において、もし、その環境中に $SiO_2$  や $Si_3N_4$ 、Si、W などの微粉末状固形物が存在すると、プラズマ処理容器内に用いられている部材は、化学的腐食とともに、前記微粒子によるエロージョン損傷の両方の作用を強く受けることになる。

5

10

しかも、プラズマが励起された環境は、Ar ガスのように腐食性のない気体でもイオン化し、これが固体面に強く衝突する現象(イオンボンバードメント)が発生するので、上記容器内に配設されている各種部材は、より一層強い損傷を受けることになる。

従来、こうした化学的腐食やエロージョン損傷を受ける場合に適用される技術としては、 $Al_2O_3$  薄膜の皮膜を形成する方法などがあった。しかし、これらの技術は、次のような問題点があった。

- (1)Al および Al 合金を陽極酸化処理して耐食性を付与した  $Al_2O_3$  膜(ア I ルマイト)を被覆した材料については、ハロゲンガスを含む雰囲気中でプラズ マエロージョンを受けると寿命が短いという問題がある。また、Al を含む皮膜なので、 $AlF_3$  のパーティクルが発生し、製造する半導体の製品不良を招くお それがある。

そこで、本発明の目的は、ハロゲンガスが含まれるような環境下での、化学 25 的腐食による損傷と、プラズマエロージョンによる損傷とに、対する抵抗力の 大きい、プラズマ処理容器等の表面処理部材と、それの有利な製造方法とを提 案することにある。

#### 発明の開示

本発明は、従来技術が抱えている上述した問題ならびに欠点を、以下に要約 して述べる解決手段の採用によって克服したものである。 すなわち、本発明の 構成を整理すると、次の通りである。

- 5 (1) 基材の表面に、溶射法によって気孔率  $0.2\sim10\%$ 、厚さ  $5.0\sim2000\,\mu$  mの  $Y_2O_3$  溶射皮膜のみからなる層を形成してなる被覆部材であること。
- (2) 腐食性が強い環境の場合、例えば、ハロゲン化合物を含む雰囲気中におけるプラズマ発生条件下で、基材の表面に、アンダーコートとして、好ましくは溶射法により、 $Y_2O_3$  溶射皮膜との密着性に優れた、Ni およびその合金、Ni およびその合金、Ni およびその合金、Ni およびその合金、Ni およびその合金、Ni およびその合金の中から選ばれる 1 種以上の金属・合金の皮膜を、 $50\sim500\mu$  mの厚さに被覆し、そしてそのアンダーコートの上に、 $N_2O_3$  溶射皮膜を $50\sim2000\mu$  m厚さに施工して複合層を形成してなる被覆部材であること。
- (3) 腐食性がより強い環境の場合、基材の表面に、前記金属皮膜(好まし 15 くは溶射皮膜)をアンダーコートとして施工した後、そのアンダーコートの上 に、中間層として  $Al_2O_3$  の皮膜(好ましくは溶射皮膜)を形成し、さらにその 中間層の上に、トップコートとして溶射によって前記  $Y_2O_3$  溶射皮膜を形成し てなる多層状複合層を形成した被覆部材であること。
- (5) なお、上記の方法において、基材の表面に、直接またはアンダーコー 25 トや中間層を施工した上に間接的に形成する  $Y_2O_3$  溶射皮膜は、純度 9.5%以上の  $Y_2O_3$  粉末を使用し、この粉末を大気中でプラズマ溶射するか、実質的に酸素を含まない Ar ガスの減圧雰囲気下でプラズマ溶射するか、あるいは高速

WO 01/42526 PCT/JP00/08584

フレーム溶射法や爆発溶射法などから選ばれた溶射方法を適用して得られる溶射皮膜を被覆した部材であること。

なかでも、Ar ガス減圧プラズマ溶射による方法が、耐食性の改善にも有効である。

5

## 発明を実施するための最良の形態

発明者らの研究によると、従来技術が抱えている上述した問題について、それの解決のために研究した結果、プラズマ処理容器内部材の損傷は、ハロゲンガスによる化学的腐食による損傷と、プラズマエロージョンによる損傷とであることを突き止めた。そして、前記部材がプラズマによって励起されたハロゲンを含む雰囲気中で使用される場合には、とくに耐プラズマエロージョン性を起因とする損傷を防ぐことこそが重要であり、そうすれば化学的腐食防止に対しても有効に作用するとの知見を得た。

そこで、本発明では主として、耐プラズマエロージョン性に対して有効な皮 15 膜の形成について研究した。その結果として、上掲の本発明にかかる部材を開 発した。

すなわち、その課題解決の手段として採用した本発明は、基本的には、金属、セラミックス、炭素材料などの基材表面に、溶射法によって、 $Y_2O_3$  のみからなる溶射皮膜を形成したものである。そして、こうした部材が使用される環境の の食性が強い場合には、前記  $Y_2O_3$  溶射皮膜の下に、耐ハロゲンガス腐食性の強い特性を示す金属のアンダーコートを設けると共に、さらには  $Al_2O_3$  や  $Y_2O_3$  の中間層をも設けて複合化させたものを開発した。

以下、本発明にかかる部材の構成について詳しく説明する。

#### (1) 基材について

25 上記溶射皮膜の施工対象となる基材としては、ステンレス鋼を含む各種の鋼、 アルミニウムおよびアルミニウム合金、タングステンおよびタングステン合金、 チタンおよびチタン合金、モリブデンおよびモリブデン合金および炭素ならび 10

に酸化物系、非酸化物系セラミックス焼結体、あるいは炭素質材料などが好適である。

なお、銅および銅合金は、プラズマエロージョンやハロゲン化合物による腐食作用によって放出され、環境汚染の原因となるので好ましくない。従って、もし装置の構成上、銅および銅合金の使用が必要な場合は、電気めっき、化学めっき、蒸着などの手段で Cr、Ni などで被覆しておく必要がある。

#### (2)皮膜構成について

上記基材表面への皮膜の形成は、基材をブラスト処理した後、 $Y_2O_3$  を直接に溶射して成膜するか、または、基材表面にまずアンダーコート層として、耐ハロゲンガス腐食性の強い金属材料からなる皮膜を、PVD処理、CVD処理もしくは溶射処理して形成し、そのアンダーコートの上に  $Y_2O_3$  粉末をトップコートとして溶射して複合層としたものが好ましい。この場合において、前記金属アンダーコート (溶射皮膜等) は、膜厚は  $50\sim500\mu$  mの範囲内とする。アンダーコート層が  $50\mu$  m より薄いとアンダーコートとしての作用効果が弱く、一方、 $500\mu$  m を超える厚さでは効果が飽和するので肥厚化の意味がなく、得策でないからである。

かかるアンダーコート用金属材料としては、ニッケルおよびニッケル合金、 タングステンおよびタングステン合金、モリブデンおよびモリブデン合金、チ タンおよびチタン合金などが好適である。

20 一方、トップコートとなる  $Y_2O_3$  溶射皮膜は、基材表面に直接施工したものであれ、また、前記アンダーコートの上に溶射して複合層にしたものであれ、さらには中間層として  $Al_2O_3$  や  $Al_2O_3+Y_2O_3$  皮膜を設けた場合であれ、いずれにしても  $50\sim2000\,\mu$ mの厚さに施工することが好ましい。その理由は、  $50\,\mu$ mより薄い層ではプラズマエロージョンによる損傷の防止に対して効果が乏しく、一方、  $2000\,\mu$ mより厚くしても効果が飽和して経済的でないからである。

なお、トップコートの  $Y_2O_3$  溶射皮膜の気孔率は、 $0.5 \sim 10\%$ の範囲がよい。 0.5%以下の皮膜は溶射法では製造が困難であり、また、10%以上の気孔率

5

10

20

の皮膜では耐食性、耐プラズマエロージョン性に劣るからである。

## (3) 部材最表面層の Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 溶射皮膜について

本発明の最も特徴とする構成は、基材の最表層の構成として、ハロゲンガスを含む雰囲気中で耐プラズマエロージョン性を示す材料として  $Y_2O_3$  を採用し、これを溶射層として被覆形成するところにある。即ち、本発明者らの研究によると、 $Y_2O_3$  は、比重が 4.84、融点が 2410 で、酸素との化学的結合力が強いため、ハロゲンガスを含む雰囲気中でプラズマエロージョン作用をうけても、安定した状態を維持することがわかった。ただし、この  $Y_2O_3$  については、純度が 95%以上のものを用いることが必要であり、Fe、Mg、Cr、Al、Ni、Si などの不純物が酸化物として含まれていると、耐エロージョン性が低下するので好ましくない。 98%以上の純度のものがより好ましい。

なお、この  $Y_2O_3$  溶射皮膜の直下に形成させる中間層の  $Al_2O_3$  は、化学的に安定であるうえ、大気プラズマ溶射や減圧プラズマ溶射環境下においても変化が少なく、 $Y_2O_3$  の耐プラズマエロージョン性を補償する作用を担うものである。

#### 15 (4)被覆方法

#### a. 溶射皮膜の形成

本発明においては、少なくとも最表層トップコートの Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 皮膜は溶射皮膜とする。そして、好ましくはこのトップコート溶射皮膜下にはこの皮膜をさらに強化する意味で、全体の皮膜構成を次のような多層構造にすることが好ましい。

即ち、基材の表面に、金属溶射皮膜のアンダーコートを施工した後、その上に  $\mathrm{Al}_2 0_3$  溶射皮膜もしくは傾斜配合にかかる  $\mathrm{Al}_2 0_3$  と  $\mathrm{Y}_2 0_3$  との混合物溶射皮膜を中間層として施工し、さらに、その上にトップコートとして、 $\mathrm{Y}_2 0_3$  溶射皮膜を形成するのである。

25 このような皮膜構成が好ましい理由は、金属溶射皮膜に比較して耐食性、耐プラズマエロージョン性に優れる  $\mathrm{Al}_2\mathrm{O}_3$  を中間層として形成することで、溶射皮膜を多層構造化し、皮膜の貫通気孔を少なくして耐食性、耐エロージョン性

5

25

を向上させることができるからである。しかも、中間層としての  $Al_2O_3$  は、アンダーコートおよびトップコートの両方とも良好な密着性を発揮する。この意味において、中間層は、 $Al_2O_3$  と  $Y_2O_3$  との混合物の層とすることがより好ましく、この場合、アンダーコート側の  $Al_2O_3$  濃度を高くする一方、トップコート側では  $Y_2O_3$  濃度が高くなるような傾斜配合にかかる混合層とすることが好ましい。このような中間層の形成は、溶射法を採用すると容易に施工することができるので、中間層が溶射皮膜として形成されることは好ましい実施形態といえる。なお、中間層の厚さは、トップコートの  $Y_2O_3$  溶射皮膜と同一の範囲が好適である。

10 本発明において、金属や  $\mathrm{Al}_2\mathrm{O}_3$ 、 $\mathrm{Y}_2\mathrm{O}_3$  の溶射皮膜を形成するには、大気プラズマ溶射法または、実質的に酸素を含まない雰囲気中でのプラズマ溶射法が好適であるが、高速フレーム溶射や爆発溶射法による施工も可能である。

b. CVD法およびPVD法によるアンダーコート,中間層の形成

CVD法では、所要の金属ハロゲン化合物の蒸気を、水素などによって還元 15 析出させ、その後酸素または酸素化合物によって酸化させるが、大気中で加熱 することによって、酸化物皮膜に変化させることによって成膜する。

一方、PVD法では、焼結体または粉末を原料とし、これに電子ビームを照 射して揮散させ、これを基材表面に析出させることによって成膜する。

一般に、CVD法、PVD法による皮膜の形成は、薄膜(例えば50μm前20 後)の施工に適している。

(5) 本発明にかかる部材の使用環境について

本発明にかかる部材表面に被覆した  $Y_2 O_3$  溶射皮膜は、ハロゲン化合物を含む雰囲気下において発生するプラズマ環境下で使用する場合に特に有用である。

もちろん、ハロゲン元素またはハロゲン化合物を含まない $N_2$ 、 $H_2$  などの雰囲気下におけるプラズマエロージョン作用に対しても本発明は有効であり、この場合は、とくにハロゲン元素、化合物を含む雰囲気に比較して、エロージョン損傷が緩やかであるので、本発明にかかる皮膜被覆部材は長期間にわたって

安定した性能を発揮する。

#### 実施例

10

15

### 実施例1

この実施例では、アルミニウム製試験片(寸法:幅  $50\text{mm} \times$ 長  $50\text{mm} \times$ 厚 5mm)の片面をブラスト処理によって粗面化した後、 $Y_2O_3$  溶射材料を用いて大気プラズマ溶射法と、Ar ガスで雰囲気圧力を 5  $0 \sim 200\text{hPa}$  に制御した減圧プラズマ溶射法によって、それぞれ膜厚  $300\,\mu$  mの  $Y_2O_3$  溶射皮膜を形成した。

また、アルミニウム製試験片の片面に、大気プラズマ溶射法によって、Ni-20%Al 合金のアンダーコートを、膜厚  $100\mu$ m厚に施工したあと、前記  $Y_2O_3$ をトップコートとして  $300\mu$ m厚に被覆したものを作製した。

その後、これらの試験片表面に形成されている  $Y_2O_3$  溶射皮膜の気孔率、密着強さ、および熱衝撃試験(500  $^{\circ}$  に維持されている電気炉中で 20 分間加熱した後、炉外にて空冷の操作を 1 サイクルとして 10 サイクル繰り返す試験)を行った。なお、比較例として、 $Al_2O_3$  の溶射皮膜についても同じ条件、同じ工程で施工したものを供試した。

表1は、このときの試験結果をまとめたものである。

本発明に適合する皮膜は、試験片の表面に  $Y_2O_3$  皮膜を直接被覆したもの (No. 1、3)をはじめ、アンダーコートを施した上に  $Y_2O_3$  皮膜を形成したもの (No. 2、4)を含む全ての皮膜が良好な密着性と耐熱衝撃性を示し、 $Al_2O_3$  皮膜に比較しても全く遜色がない。とくに、減圧プラズマ溶射法で形成された  $Y_2O_3$  皮膜は、大気溶射法の皮膜に比較して気孔率が少ないので、良好な耐食性も期待できる。

表 1

,,	المراجع	皮膜の構成		気孔率	密着強さ	熱衝撃試験	備
No.	溶射法	アンダーコート	トップコート	(%)	(MPa)	外観目視	考
1	大気	なし	Y 2 O 3	5 ~ 9	35 ~ 38	剥離なし	
2	プラズマ	Ni - 20Al	Y,03	6 ~ 8	38 ~ 41	剥離なし	実施
3	減圧	なし	Y,0,	0.2 ~ 3	40 ~ 41	剥離なし	例
4	プラズマ	Ni-20Al	Y,03	0.3 ~ 4	40 ~ 44	剥離なし	
5	大気	なし	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	8 ~ 12	38 ~ 42	剥離なし	
6	プラズマ	Ni - 20Al	Al,0,	9 ~ 12	35 ~ 44	剥離なし	比較
7	減圧	なし	Al,03	0.5 ~ 5	38 ~ 44	剥離なし	例
8	プラズマ	Ni - 20Al	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.6 ~ 7	39 ~ 43	剥離なし	

(備者)

(1) 皮膜厚さ:アンダーコート 100μm、トップコート 300 μm

(2) 密着強さは JIS H8666 セラミック溶射皮膜試験方法規定の密着強さ試験法による。

(3) 熱衝擊試験:500℃×20min →室温(空冷)

繰り返し10回後の外観観察

#### 実施例2

5

この実施例では、50m×100m×5mm 厚のアルミニウム製基材を用いて、表2に示すような表面処理を施した後、それぞれの基材から寸法20mm×20 mm×5mm の試験片を切り出し、さらに表面処理面が10mm×10mm の範囲が露出するように他の部分をマスクし、下記条件にて20時間照射して、プラズマエロージョンによる損傷量を減肉厚さとして求めた。

(1) ガス雰囲気と流量条件

CF、Ar、0,の混合ガスを下記条件の雰囲気とした。

 $CF_4/Ar/0_2 = 100/1000/10(1分間当たりの流量 c m^3)$ 

(2) プラズマ照射出力

高周波電力

: 1300W

圧力

: 133.3Pa

その試験結果を表 2 に示した。この表 2 に示す結果から明らかなように、比 20 較例 (現行技術)による陽極酸化皮膜 (No.8)をはじめ、 $B_4$ C 溶射皮膜 (No. 1 0)は、いずれもプラズマエロージョンによる損傷量が大きく、実用的でな

いことがうかがえる。ただ、比較例においても  $\mathrm{Al}_20_3$  溶射皮膜 (No. 9) は比較的良好な耐プラズマエロージョン性を示した。

これに対し、本発明の  $Y_2O_3$  溶射皮膜は、極めて優れた耐プラズマエロージョン性を発揮し、ハロゲン化合物を含む雰囲気下においても良好な性能を維持することが認められた。

表 2

No.	溶射法	表面処理法	アンダーコートの 有無	エロージョン 損失深さ (μm)	備考
1	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (99.9 %)	溶 射	有	6.2	
2	1203 (33.3 %)	(日) (日)	無	6.1	
3	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (99.8 %)	溶射	有	7.6	実
4	1,03 (33.8 %)	(合物)	無	7.2	施例
5	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (99.5 %)	溶射	有	6.5	
6	1,0, (33.3 %)	俗多列	無	6.3	
7	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (99.9 %)	PVD	無	6.6	
8	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	陽極酸化	無	39.5	比
9	Al <sub>1</sub> 0 <sub>3</sub>	溶 射	有	8.1	較
10	B <sub>4</sub> C	溶 射	有	28.0	例
11	石英	_	無	39.0	

(備考)

- (1) 溶射は大気プラズマ溶射法を用い、アンダーコートの膜厚  $80 \mu m$   $Y_10_1$ ,  $Al_10_1$ などのトップコートの膜厚は  $200 \mu m$ に成膜
- (2) アンダーコートの材質は80%Ni-20%Al
- (3) 陽極酸化は JIS H8601 規定の AA25 に準じて成膜させたものである。

#### 実施例3

10

2の実施例では、幅50m×長さ100m×厚5mmのアルミニウム製基材上に、アンダーコートとして80%Ni-20%Al を80 $\mu$ m、中間層として $Al_2O_3$ 、または $Al_2O_3$  50 $vol\%/Y_2O_3$  50vol%の混合物を $100\mu$ m、その上に $Y_2O_3$ を $200\mu$ m厚に、それぞれ大気プラズマ溶射法によって成膜した後、実施例2の条件でプラズマエロージョン試験を実施した。

その結果、本発明の溶射皮膜は、最表層部(トップコート)に  $Y_2O_3$  溶射皮膜を形成している限り、中間層として  $Al_2O_3$ 、 $Al_2O_3$ / $Y_2O_3$  混合物層を配設しても、耐プラズマエロージョン性には影響を受けず、 2 0 時間の照射で 6.1~7.5 $\mu$ mの消失が認められたに過ぎず、多層構造皮膜でも十分な性能を発揮することが認められた。

#### 実施例4

5

25

この実施例では、現行のアルミニウム製基材を陽極酸化(アルマイト処理) した試験片と、基材上にアンダーコートとして 80%Ni -20%Al の合金皮膜を  $100\mu$ m厚に被覆し、その上にトップコートとして  $Y_2O_3$  皮膜を  $250\mu$ m、

- 10 それぞれプラズマ溶射法によって形成した試験片を用いて、下記の条件でプラ ズマエッチングを行い、エッチングによって削られて飛散するパーティクル (粒子)の数は同じチャンバー内に静置した直径8インチのシリコンウエハー の表面に付着する粒子数によって比較した。なお、付着する粒子数は表面検査 装置によって調査し、概ね粒径0.2μm以上の粒子を対象にして行った。
- 15 (1)ガス雰囲気と流量条件

CHF<sub>3</sub>、 $0_2$ 、Ar をそれぞれ下記のような混合比で流通した。 CHF<sub>3</sub>/ $0_2$ /Ar=80/100/160 (1分間当たりの流量 c m<sup>3</sup>)

(2) プラズマ照射出力

高周波電力 : 1300W

20 圧力 : 4 Pa

温度 : 60℃

この実験の結果、陽極酸化 (アルマイト膜) した試験片では、プラズマ照射 17.5 時間後、一般的なチャンバー内のパーティクル管理値の30個を超え2 5 時間後では150個以上となった。このパーティクルの組成は、Al、Fからなるものであった。

これに対し、本発明に適合する  $Y_2O_3$  溶射皮膜では、70 時間照射後になって、やっと管理限界値を超える程度にとどまり、優れた耐プラズマエロージョ

ン性を示した。

#### 産業上の利用可能性

以上説明したように本発明によれば、金属質、または非金属質基材の上に、 $Y_2O_3$  溶射皮膜を直接形成するか、金属質のアンダーコートを施工した上に、  $Y_2O_3$  溶射皮膜を形成した部材では、ハロゲン化合物を含むガス雰囲気下におけるプラズマエロージョン作用を受ける環境下で使用した場合に、優れた抵抗性を示す。このため、長時間にわたってプラズマエッチング作業を続けても、チャンバー内はパーティクルによる汚染が少なく、高品質製品を効率よく生産することが可能となる。また、チャンバー内のパーティクルによる汚染速度が遅くなるため、清浄化作業の間隔が長くなり、生産性の向上が期待でき、半導体製造装置や液晶デバイスなどの分野における、プラズマ処理容器内部材として極めて有効である。

- 20

# 請 求 の 範 囲

- 1. 基材の表面が  $Y_2O_3$  溶射皮膜によって被覆されていることを特徴とする、プラズマ処理容器内部材。
- 5 2. 基材の表面に、アンダーコートとして形成された金属皮膜を有し、そのアンダーコートの上には、トップコートとして形成された  $Y_2O_3$  溶射皮膜を有する、プラズマ処理容器内部材。
  - 3. 基材表面に、アンダーコートとして形成された金属皮膜を有し、そのアンダーコートの上には中間層を有し、その中間層の上にはトップコートとして形
- 10 成された  $Y_2O_3$  溶射皮膜を有することを特徴とする、プラズマ処理容器内部材。 4. アンダーコートの金属皮膜は、Ni およびその合金、Wおよびその合金、 Mo およびその合金、Ti およびその合金から選ばれたいずれか 1 種以上の金属、 合金を用いて 5 0 ~ 500  $\mu$  m厚に形成された皮膜であることを特徴とする、請求の範囲 1 、2 または 3 に記載のプラズマ処理容器内部材。
- 15 5. 中間層は、 $Al_2O_3$ もしくは  $Al_2O_3$ と  $Y_2O_3$ との混合物の層にて形成されていることを特徴とする、請求の範囲1、2または3に記載のプラズマ処理容器内部材。
  - 6. 中間層は、アンダーコート側では  $Al_2O_3$  の濃度が高く、一方トップコート側では  $Y_2O_3$  の濃度が高い傾斜濃度をもつ層にて形成されていることを特徴とする、請求の範囲 5 に記載のプラズマ処理容器内部材。
  - $7. Y_2O_3$  溶射皮膜は、気孔率が  $0.5\sim10\%$ 、膜厚  $5.0\sim2000\mu$  mの皮膜であることを特徴とする、請求の範囲 1、 2 または 3 に記載のプラズマ処理容器内部材。
- 8. 基材の表面に、 $Y_2O_3$  を溶射法にて被覆して、 $Y_2O_3$  溶射皮膜を形成するこ 25 とを特徴とする、プラズマ処理容器内部材の製造方法。
  - 9. 基材の表面に、CVD法、PVD法あるいは溶射法のいずれか1種以上の表面処理法を適用し、アンダーコートとして、Ni、W、Mo もしくは Ti およ

びそれらの合金からなる金属の層を被覆し、その上アンダーコートの上にトップコートとして、 $Y_2O_3$ を被覆することにより複合層とすることを特徴とする、プラズマ処理容器内部材の製造方法。

10. 基材の表面に、CVD法、PVD法あるいは溶射法のいずれか1種以上の表面処理法を適用し、Ni、W、Mo もしくは Ti およびその合金からなる金属を被覆してアンダーコートを形成し、次いでそのアンダーコートの上に、 $Al_2O_3$ もしくは  $Al_2O_3$ と  $Y_2O_3$ との混合物を被覆して中間層を形成し、その後その中間層の上に、 $Y_2O_3$  を被覆してトップコートを形成して複合層とすることを特徴とする、プラズマ処理容器内部材の製造方法。

10

5